

а 2022 0012

Изобретение относится к технологии изготовления наноструктурированных материалов, в частности к способам получения магнитных наноструктур, которые могут быть использованы в микроэлектронике, спинтронике или хранении информации.

Способ, согласно изобретению, состоит в изготовлении неорганической наноматрицы со слоем нанонитей GaAs способом анодирования в электролитическом растворе 1М HNO₃ пластины GaAs с кристаллографической ориентацией (111)В или (001), после чего на поверхность наноматрицы с полученными нанонитями гальваностатическим способом в электролитическом растворе 0,01 моль/л FeSO₄, 0,03 моль/л (NH₄)₂SO₄ и 0,3 моль/л Na₂SO₄ с рН 5,1 в течении 15...20 с осаждается магнитный слой Fe, образуя вокруг нанонитей нанотрубки с анизотропными магнитными свойствами.

П. формулы: 3

Фиг.: 4